

## 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2000年 3月31日

出願番号

Application Number:

特願2000-097187

出 願 人
Applicant(s):

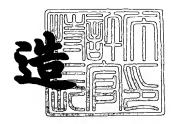
株式会社オートネットワーク技術研究所

住友電装株式会社 住友電気工業株式会社

2001年 7月27日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】 特許願

【整理番号】 26884

【提出日】 平成12年 3月31日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B60R 16/02

【発明の名称】 車両用パワーディストリビュータ

【請求項の数】 14

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県名古屋市南区菊住1丁目7番10号 株式会社ハ

ーネス総合技術研究所内

【氏名】 鬼塚 孝浩

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県名古屋市南区菊住1丁目7番10号 株式会社ハ

ーネス総合技術研究所内

【氏名】 山根 茂樹

【特許出願人】

【識別番号】 395011665

【住所又は居所】 愛知県名古屋市南区菊住1丁目7番10号

【氏名又は名称】 株式会社ハーネス総合技術研究所

【特許出願人】

【識別番号】 000183406

【住所又は居所】 三重県四日市市西末広町1番14号

【氏名又は名称】 住友電装株式会社

【特許出願人】

【識別番号】 000002130

【住所又は居所】 大阪市中央区北浜四丁目5番33号

【氏名又は名称】 住友電気工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100067828

【弁理士】

【氏名又は名称】 小谷 悦司

【選任した代理人】

【識別番号】 100075409

【弁理士】

【氏名又は名称】 植木 久一

【選任した代理人】

【識別番号】 100109058

【弁理士】

【氏名又は名称】 村松 敏郎

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 012472

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9710168

【包括委任状番号】 9709350

【包括委任状番号】 9715685

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 車両用パワーディストリビュータ

【特許請求の範囲】

【請求項1】 車両に搭載された共通の電源から複数の電子ユニットに配電を行うためのパワーディストリビュータであって、前記電源に接続される入力端子と、前記各電子ユニットに接続される複数の出力端子と、これらの出力端子に対応して設けられ、前記入力端子に接続される第1の通電端子及び前記出力端子に接続される第2の通電端子とこれらの通電端子同士の通電を制御する信号が入力される通電制御端子とを有する複数の半導体スイッチング素子と、いずれかの半導体スイッチング素子を流れる電流が予め設定された遮断電流を超える場合に当該半導体スイッチング素子を強制的にオフに切換える制御回路とを備えるとともに、各半導体スイッチング素子と直列にヒューズ部が配設され、前記半導体スイッチング素子が正常にオフ切換しなくなったときには前記ヒューズ部の溶断によりその下流側の回路が過電流から保護されることを特徴とするパワーディストリビュータ。

【請求項2】 請求項1記載のパワーディストリビュータにおいて、前記ヒューズ部は、前記遮断電流よりも大電流側の溶断特性をもつものであることを特徴とするパワーディストリビュータ。

【請求項3】 請求項2記載のパワーディストリビュータにおいて、前記ヒューズ部は、前記半導体スイッチング素子自体の許容電流よりも大電流側の溶断特性をもつものであることを特徴とするパワーディストリビュータ。

【請求項4】 請求項1~3のいずれかに記載のパワーディストリビュータ において、前記ヒューズ部は各出力端子の途中部分に設けられていることを特徴 とするパワーディストリビュータ。

【請求項5】 請求項4記載のパワーディストリビュータにおいて、前記出力端子が金属板で構成され、かつ、外部回路に接続される端子本体部と半導体スイッチング素子の第2の通電端子に接続される素子接続部とに分割されるとともに、これら端子本体部と素子接続部とに両者をつなぐようにして前記溶断特性をもつヒューズ部材が直接取付けられていることを特徴とするパワーディストリビ

ユータ。

【請求項6】 請求項5記載のパワーディストリビュータにおいて、前記ヒューズ部材の両端部が前記端子本体部の端部及び素子接続部の端部にそれぞれ溶接されていることを特徴とするパワーディストリビュータ。

【請求項7】 請求項5または6記載のパワーディストリビュータにおいて、前記半導体スイッチング素子を収納するケースを備え、このケースに前記ケース本体側に突出して各ヒューズ部材同士を隔離する隔離部が設けられていることを特徴とするパワーディストリビュータ。

【請求項8】 請求項7記載のパワーディストリビュータにおいて、前記ケースが、前記各半導体スイッチング素子が組み込まれるケース本体と、前記各半導体スイッチング素子を覆うように前記ケース本体に装着されるカバーとで構成されるとともに、このカバーの裏面に前記隔離部が前記ケース本体側に向けて突設され、このカバーを前記ケース本体に装着した状態で前記隔離部により各ヒューズ部材同士が隔離されるように構成されていることを特徴とするパワーディストリビュータ。

【請求項9】 請求項5~8のいずれかに記載のパワーディストリビュータにおいて、前記出力端子及び入力端子が金属板により形成され、これらの端子がその厚さ方向と直交する同一平面上に並べて配されていることを特徴とするパワーディストリビュータ。

【請求項10】 請求項9記載のパワーディストリビュータにおいて、前記各半導体スイッチング素子の通電制御端子に接続される制御用端子を備え、この制御用端子、前記入力端子、及び出力端子が金属板により形成され、かつ、その厚さ方向と直交する同一平面上に並べて配されていることを特徴とするパワーディストリビュータ。

【請求項11】 請求項10記載のパワーディストリビュータにおいて、前記制御回路が組み込まれた制御回路基板が前記入力端子、出力端子、及び制御用端子が並べられている平面と略平行な状態で配設され、この制御回路基板に前記入力端子、出力端子、及び制御用端子が電気的に接続されていることを特徴とするパワーディストリビュータ。

【請求項12】 請求項11記載のパワーディストリビュータにおいて、前記制御回路は、前記入力端子の電圧と各出力端子の電圧との差に基づいて各半導体スイッチング素子を流れる電流の大きさに相当する値を演算し、この値が予め設定された遮断電流を超える場合に前記制御用端子を通じて半導体スイッチング素子の通電制御端子にこの半導体スイッチング素子を強制的にオフにする制御信号を出力することを特徴とするパワーディストリビュータ。

【請求項13】 請求項9~12のいずれかに記載のパワーディストリビュータにおいて、略同一平面上に配置されている各端子が樹脂モールドにより一体化され、この樹脂モールドによりケース本体が構成されていることを特徴とするパワーディストリビュータ。

【請求項14】 請求項13記載のパワーディストリビュータにおいて、前記ケース本体に各出力端子の途中部分を露出させる窓が形成され、この窓から露出する出力端子部分に前記ヒューズ部が設けられていることを特徴とするパワーディストリビュータ。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

#### 【発明の属する技術分野】

本発明は、車両に搭載されたバッテリー等の電源からセンタークラスタ用ユニット、エアコン用ユニット、ドア用ユニットといった複数の電子ユニットに配電を行うための車両用パワーディストリビュータに関するものである。

[0002]

### 【従来の技術】

従来、共通の車載電源から各電子ユニットに電力を分配する手段として、複数 枚のバスバー基板を積層することにより配電用回路を構成し、これにヒューズや リレースイッチを組み込んだ電気接続箱が一般に知られている。

[0003]

さらに近年は、かかる電気接続箱の小型化や高速スイッチング制御を実現すべく、前記リレーに代えてFET等の半導体スイッチング素子を入力端子と出力端子との間に介在させたパワーディストリビュータの開発が進められている。例え

ば特開平10-126963号公報には、電源入力端子につながる金属板に複数の半導体スイッチング素子のドレイン端子が接続されるとともに、これら半導体スイッチング素子のソース端子がそれぞれ別個の電源出力端子に接続され、各半導体スイッチング素子のゲート端子が制御回路基板に接続されたものが開示されている。

[0004]

さらに、同公報の装置では、各半導体スイッチング素子とは別に半導体スイッチ制御チップが制御基板に搭載され、半導体スイッチング素子に過電流が流れたり半導体スイッチング素子が過熱した場合に前記半導体スイッチ制御チップから各半導体スイッチング素子のゲート端子に当該素子を強制的にオフにするための制御信号が入力されるようになっている。このように各半導体スイッチング素子にヒューズ機能が付加されることにより、従来の電気接続箱のように交換作業を要する大型のヒューズブロックをケースに組み込むといった必要性がなくなり、メンテナンス作業が簡略化される。

[0005]

### 【発明が解決しようとする課題】

前記公報に示される装置では、半導体スイッチング素子に流れる過電流や半導体スイッチング素子の過熱により、当該半導体スイッチング素子が故障して作動不良を起こすおそれがある。かかる作動不良が生じると、その半導体スイッチング素子のゲート端子に強制オフの制御信号を入力しても半導体スイッチング素子がオフ切換せず、ヒューズ機能が働かなくなるおそれがある。

[0006]

本発明は、このような事情に鑑み、半導体スイッチング素子を利用したパワーディストリビュータにおいて、メンテナンス作業の簡略化を図りながら、出力端子に接続される回路要素(例えばワイヤハーネス)を過電流から確実に保護することを目的とする。

[0007]

#### 【課題を解決するための手段】

前記課題を解決するための手段として、本発明は、車両に搭載された共通の電

源から複数の電子ユニットに配電を行うためのパワーディストリビュータであって、前記電源に接続される入力端子と、前記各電子ユニットに接続される複数の出力端子と、これらの出力端子に対応して設けられ、前記入力端子に接続される第1の通電端子及び前記出力端子に接続される第2の通電端子とこれらの通電端子同士の通電を制御する信号が入力される通電制御端子とを有する複数の半導体スイッチング素子と、いずれかの半導体スイッチング素子を流れる電流が予め設定された遮断電流を超える場合に当該半導体スイッチング素子を強制的にオフに切換える制御回路とを備えるとともに、各半導体スイッチング素子と直列にヒューズ部が配設され、前記半導体スイッチング素子が正常にオフ切換しなくなったときには前記ヒューズ部の溶断によりその下流側の回路が過電流から保護されるものである。

## [0008]

なお、「予め設定された遮断電流」とは、時間経過にかかわらず一定の値であってもよいし、例えば負荷電流が立ち上がってからの経過時間の関数値として設定されたものであってもよい。

#### [0009]

前記構成によれば、いずれかの半導体スイッチング素子を流れる電流が予め設定された遮断電流を超える場合に、当該半導体スイッチング素子を強制的にオフに切換える制御が行われることにより、過電流の続行が防止される。さらに、前記半導体スイッチング素子が前記過電流や過熱によって故障して正常にオフ切換しなくなっても、これと直列に配されているヒューズ部が溶断することにより、その下流側の回路(ワイヤハーネスその他の回路構成要素)は過電流から確実に保護(すなわち二重保護)される。

#### [0010]

しかも、前記ヒューズ部は半導体スイッチング素子あるいはその制御回路が作動不良を起こして半導体スイッチング素子が正常にオフ切換しなくなった場合にのみ溶断すればよく、半導体スイッチング素子が正常に作動する間はその強制オフ切換により回路遮断するようにすればよいので、ヒューズ部が溶断する頻度をきわめて低くすることが可能である。

## [0011]

具体的には、前記ヒューズ部が前記遮断電流よりも大電流側の溶断特性をもつものとすればよい。このようにすれば、通常は、実際の電流が前記遮断電流を超えた時点で、前記ヒューズ部が溶断する前に必ず半導体スイッチング素子が強制オフ切換されて回路を遮断するので、この過電流が生じた後は半導体スイッチング素子の強制オフ状態を解除するだけで配電回路を復帰させることが可能である。従って、ヒューズブロックが組み込まれているだけの従来の電気接続箱のようなヒューズ交換の煩わしさがない。

#### [0012]

さらに、前記ヒューズ部が、前記半導体スイッチング素子自体の許容電流(すなわち半導体スイッチング素子の作動不良が発生するおそれのある最小電流)よりも大電流側の溶断特性をもつものとすることにより、半導体スイッチング素子の故障を招くおそれのない程度のレベルの電流でヒューズ部が溶断してしまうのを避けることができ、過電流防止効果を十分に維持しながらヒューズ部の溶断頻度をさらに低くすることができる。

#### [0013]

このように、本発明にかかるヒューズ部は、その溶断頻度が極めて低く、従来の電気接続箱に組み込まれるヒューズブロックと違って基本的に交換を必要としないものであるため、設計の自由度が高く、構造の簡素化が可能である。例えば、このヒューズ部は前記各出力端子の途中部分に設けられるものとすることができる。

#### [0014]

その具体的構造としては、前記出力端子が金属板で構成され、かつ、外部回路に接続される端子本体部と半導体スイッチング素子の第2の通電端子に接続される素子接続部とに分割されるとともに、これら端子本体部と素子接続部とに両者をつなぐようにして前記溶断特性をもつヒューズ部材が直接取付けられているものが好適である。この構成では、出力端子を分割してその分割部分にヒューズ部材を直接介在させるだけのきわめて簡素な構造で、ヒューズ部の構築が可能である。従って、従来のようなヒューズブロックを用いる場合に比べ、構造がより簡

素化及び小型化される。

[0015]

例えば、前記ヒューズ部材の両端部を前記端子本体部の端部及び素子接続部の端部にそれぞれ溶接するだけの簡単な構造で、このヒューズ部材を配電回路に組み込むことが可能であり、パワーディストリビュータの小型化及び低廉化に大きく寄与することができる。

[0016]

なお、前記のようにヒューズ部材が裸のまま出力端子に取付けられる構造では、その溶断時にヒューズ部材が周囲に飛散するおそれがあるが、前記半導体スイッチング素子を収納するケースを備え、このケースに前記ケース本体側に突出して各ヒューズ部材同士を隔離する隔離部が設けられている構成とすることにより、溶断したヒューズ部材の破片が飛散して他の導体部分と接触し短絡するといった不都合を回避することができる。

[0017]

さらに、前記ケースが、前記各半導体スイッチング素子が組み込まれるケース本体と、前記各半導体スイッチング素子を覆うように前記ケース本体に装着されるカバーとで構成されるとともに、このカバーの裏面に前記隔離部が前記ケース本体側に向けて突設され、このカバーを前記ケース本体に装着した状態で前記隔離部により各ヒューズ部材同士が隔離される構成とすれば、このカバーをケース本体から取り外した状態で、前記隔離部に邪魔されることなく各ヒューズ部材の取付作業を円滑に行うことができる。

[0018]

本発明において、前記入力端子や出力端子の具体的なレイアウトは特に問わないが、例えば、前記出力端子及び入力端子が金属板により形成され、これらの端子がその厚さ方向と直交する同一平面上に並べて配されている構成とすれば、パワーディストリビュータ全体の厚みをきわめて小さくすることかでき、その大幅なコンパクト化、薄型化を実現できる。

[0019]

また、前記各半導体スイッチング素子の通電制御端子に接続される制御用端子

を備える場合には、この制御用端子、前記入力端子、及び出力端子が金属板により形成され、かつ、その厚さ方向と直交する同一平面上に並べて配されている構成とすればよい。

### [0020]

なお、「同一平面上に配列されている」とは、必ずしも全端子の全部分が同一 平面上に並んでいるもの、すなわち全端子が平板状のものに限定する趣旨ではな く、入力端子または出力端子が一部前記「同一平面」から逸脱する形状を有する ものも含む趣旨である。例えば、基本的に同一平面に並んでいる入力端子または 出力端子の一部が折り曲げられて後述のようなタブを形成したり、端子の端部が 複数列にわたって突出する形状であったりするものでもよい。

#### [0021]

前記構成において、前記制御回路が組み込まれた制御回路基板が前記入力端子、出力端子、及び制御用端子が並べられている平面と略平行な状態で配設され、この制御回路基板に前記入力端子、出力端子、及び制御用端子が電気的に接続されたものとすれば、前記薄型構造を維持しながら制御回路を合理的に組み込むことができる。

#### [0022]

このように、入力端子、出力端子、及び制御用端子を制御回路基板に接続する構造の場合、前記制御回路は、前記入力端子の電圧と各出力端子の電圧との差に基づいて各半導体スイッチング素子を流れる電流の大きさに相当する値を演算し、この値が前記遮断電流を超える場合に前記制御用端子を通じて半導体スイッチング素子の通電制御端子にこの半導体スイッチング素子を強制的にオフにする制御信号を出力するように構成することが可能であり、これにより、簡素な回路接続で各半導体スイッチング素子の適正な強制オフ制御を実現することができる。

#### [0023]

また、各端子が略同一平面上に配置されている構造においては、これらの端子を樹脂モールドにより一体化することが可能であり、この樹脂モールドでケース本体を構成することにより、部品点数の少ない構造で各端子の配列を確実に固定することができる。

[0024]

その場合、前記ケース本体に各出力端子の途中部分を露出させる窓が形成され、この窓から露出する出力端子部分に前記ヒューズ部が設けられている構成とすることにより、各端子を一体化しながら出力端子の適所にヒューズ部を支障なく 導入することができる。

[0025]

【発明の実施の形態】

本発明の好ましい実施の形態を図面に基づいて説明する。

[0026]

まず、この実施の形態にかかるパワーディストリビュータの回路構成を図1を 参照しながら説明する。

[0027]

このパワーディストリビュータは、第1の入力端子10I及び第2の入力端子10Lと、複数(図例では11個)の出力端子12A,12B,12C,12D,12E,12F,12G,12H,12I,12I',12Jと、複数(図例では10個)の半導体スイッチング素子(図例ではパワーMOSFET14。以下、単に「FET」と称する。)と、制御回路基板18とを有している。

[0028]

前記両入力端子10I,10Lは、共通の車載電源(例えばバッテリー)に接続されるものであるが、このうち、第1の入力端子10Iは図略のイグニッションスイッチを介して前記車載電源に接続され、第2の入力端子10Lは図略のランプスイッチを介して前記車載電源に接続される。

[0029]

前記出力端子12A~12Jのうち、出力端子12A~12Hは前記イグニッションスイッチの操作により給電を受けるべき電子ユニット(例えばセンタークラスタユニットやエアコンユニット、ドアユニットなど)にそれぞれ接続され、残りの出力端子12I,12I',12Jは前記ランプスイッチの操作により給電を受けるべき電子ユニット、すなわちランプユニットに接続されている。

[0030]

各出力端子12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G, 12H, 12I, 12I', 12Jの途中部分には、過電流発生時に溶断するヒューズ部FSが設けられている。

[0031]

各FET14のソース端子(第2の通電端子)は、それぞれ前記出力端子12A,12B,12C,12D,12E,12F,12G,12H,12I,12 Jに接続されており、出力端子12Iに接続されるFET14のソース端子は同時に出力端子12I'にも接続されている。すなわち、両出力端子12I,12 I'には共通のFET14が接続されている。

[0032]

これらFET14のうち、前記出力端子12A~12Hに接続されているFET14のドレイン端子(第1の通電端子)は、全て前記第1の入力端子10Iに接続されている。これに対し、前記出力端子12I,12I′,12Jに接続されるFET14のドレイン端子は、全て前記第2の入力端子10Iに接続されている。従って、第1の入力端子10Iに入力された電源電力は、各FET14を通じて各出力端子12A~12Hにつながる電子ユニットに分配される一方、第2の入力端子10Lに入力された電源電力は、各FET14を通じて各出力端子12Ⅰ,12Ⅰ′12Jにつながる電子ユニットに分配されるようになっている

[0033]

各FET14のゲート端子(通電制御端子)は、すべて制御回路基板18の制御回路に接続されている。この制御回路には、第2の入力端子10Lに印加される電源電圧と、各FET14のソース電圧とが入力されるようになっている。この制御回路は、外部から入力される操作信号(スイッチ信号など)に基づいて各FET14の通電制御を行うとともに、前記電源電圧(入力端子10Lの電圧)と各FET14のソース電圧(出力端子12A~12Jの電圧)との電位差から当該FET14を流れる電流を演算し、この電流が予め設定された遮断電流(電流関値)を超える場合にFET14を強制的にオフにするとともに図略の表示装置に警告信号を出力するように構成されている。

[0034]

一方、各ヒューズ部FSの溶断特性は、各FET14が強制オフされる電流の 閾値(遮断電流)よりも大電流側に設定されており、仮にFET14が故障して 正常にオフ切換しなくなっても、その下流側に直列に配されたヒューズ部FSが 溶断することにより、過電流が流れ続けることが阻止されるようになっている。

[0035]

その具体的な設計例を図9に示す。図示のように、通常状態での負荷電流は、オン切換から急激に立ち上がり、その後降下して略一定値に収束する。FET遮断ライン(FET14を強制オフする電流閾値のライン;遮断電流の最大ライン)は常に前記負荷電流ラインよりも上になるような時間関数として設定され、そのさらに上にFET許容ライン(FET14自体の許容電流すなわちFET14の正常状態を確保できる最大電流)が存在する。

[0036]

本発明において、前記ヒューズ部FSの溶断特性(一般には時間ー電流特性)は、例えば破線Lに示されるように、前記FET許容ラインよりも大電流側で、かつ、出力端子に接続されるワイヤハーネスの発煙を避け得る限界電流ラインよりも小電流側の領域(図の斜線領域)に設定するのが好ましい。このような設定をすれば、仮にFET14が故障して正常にオフ切換しなくなっても、前記ワイヤハーネスの発煙が生じる前にヒューズ部FSが溶断するため、当該ワイヤハーネスが過電流から有効に保護される。逆に、FET14が正常にオフ切換する限りは、ヒューズ部FSが溶断する前にFET14の強制オフ制御により回路が遮断されるため、ヒューズ部FSが溶断する頻度はきわめて低い。従って、ヒューズ部FSを設計するにあたってその交換性を考慮する必要がなく、その結果、例えば後述のようにヒューズ部FSをきわめて簡素で低廉な構造にすることが可能である。

[0037]

前記のように、ヒューズ部FSの溶断特性を設定する領域は前記斜線領域が理想であるが、少なくともFET遮断ラインよりも上側(遮断電流よりも大電流側)に前記溶断特性を設定すれば、FET14が正常にオフ切換できるにもかかわ

らず、そのオフ切換よりも前にヒューズ部FSが溶断してしまうことを防止できる。

[0038]

次に、前記配電回路を実現するパワーディストリビュータの具体的な構造を、 図2~図8を参照しながら説明する。

[0039]

このパワーディストリビュータでは、前記配電回路を構成する導体がすべて金属板から構成され、これらの金属板がその板厚方向と直交する同一平面上に配されるとともに、樹脂モールドによって一体化されている。図2は、当該樹脂モールドを透かして前記金属板で構成された部分のみを示した平面図である。

[0040]

図示のように、第1の入力端子10I及び第2の入力端子10Lは、それぞれ 金属板20,23の端部にこれと一体に形成されている。図例では、両入力端子 10I,10Lは、板厚確保のために、前記各金属板20,23の端部をそれぞ れ2枚折りにすることにより形成され、互いに横方向(図2では上下方向)に隣 接する状態で配列され、かつ、同じ向き(図2では左向き)に突出している。

[0041]

金属板20は、前記第1の入力端子から奥側(図2では右側)に延びる中継部21と、この中継部21の奥端から当該中継部21と直交する方向に延びるドレイン接続部(導体板)22とを一体に有している。

[0042]

金属板23は、前記第2の入力端子10Lから前記金属板20の中継部21の外側(図2では上側)を通って当該中継部21と平行に延びる第1中継部24と、この第1中継部24の奥端から前記ドレイン接続部22の外側(図2では右側)を通って当該ドレイン接続部22と平行に延びる第2中継部25と、この第2中継部25の端から前方に延びるドレイン接続部26とを一体に有し、このドレイン接続部26と前記ドレイン接続部22とが当該ドレイン接続部22の長手方向(図2の上下方向)に沿って一列に並んだ状態となっている。

[0043]

全出力端子12A~12Jは、前記両入力端子10I,10Lとともに横一列に並べて配され、これらの入力端子10I,10Lと同じ向きに突出している。 出力端子12A~12Jのうち、並び方向両外側の出力端子12A~12C及び出力端子12H~12Jは小幅の小電流用出力端子とされ、並び方向中央の出力端子12D~12Gは前記小電流用出力端子よりも幅広の大電流用出力端子とされている。すなわち、大電流用出力端子12D~12Gの両外側に小電流用出力端子12A~12D及び12H~12Jが配列されている。

#### [0044]

各出力端子12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G, 12H, 12I, 12Jの後部は、前記ドレイン接続部22, 26と隣接する位置まで延びる中継部(素子接続部)28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28Jとされている。これらの中継部28A~28Jは、後方に向かうに従って(ドレイン接続部22, 26に近づくに従って)互いにピッチの広がる形状となっている。また、出力端子12I/は、出力端子12Iの中継部28Iから分岐している。すなわち、両出力端子12I, 12I/は中継部28Iを共有している。

#### [0045]

従って、前記出力端子12A~12Jの後端(すなわち中継部28A~28Jの後端)は、これら出力端子12A~12Hの先端側ピッチよりも大きなピッチで配列されている。そして、前記中継部28A~28Jのうち、中継部28A~28Hの奥端に隣接する位置に前記ドレイン接続部22が配置され、中継部28I,28Jの奥端に隣接する位置に前記ドレイン接続部26が配置されている。また、大電流用出力端子12D~12Gが並び方向中央に配されているため、その中継部28D~28Gの経路が、両外側に配された小電流用出力端子12A~12C,12H~12Jの中継部28A~28C,28H~28Jの経路よりも短くなっている。

#### [0046]

さらに、各中継部28A~28Jと隣接する位置には、略短冊状の金属板からなる制御用端子30が配設されている。すなわち、制御用端子30、中継部28

A、制御用端子30、中継部28B、制御用端子30、…という具合に、中継部と制御用端子とが横一列に交互に配列されている。

#### [0047]

各出力端子12A~12Jにおいては、その中継部28A~28Jとこれより も前方(先端側)の端子本体部分とが分断され、この分断された部分に前記ヒュ ーズ部FSが配設されている。

#### [0048]

具体的には、図5 (a) (b) に示すように、前記分断により形成された端部同士をつなぐようにヒューズ部材16が配設されている。このヒューズ部材16 の中間部16 a は小幅でかつ上に凸の向きで略U字状に曲げられており、前記図9などで説明した溶断特性を有するように設計されている。一方、ヒューズ部材16の両端部16 b は水平方向を向くまで折り返され、前記分断により形成された端部(すなわち出力端子12A~12 J の先端側部分である端子本体部の端部と中継部28A~28 J の端部)とにそれぞれ重ね合わされた状態で、当該端部に溶接(例えば抵抗溶接やレーザ溶接など)の手段により接合されている。

#### [0049]

各FET14の端子のうち、図略のドレイン端子(第1の通電端子)はチップ本体の裏面に形成され、ソース端子(第2の通電端子)14s及びゲート端子(通電制御端子)14gは前記チップ本体から同じ向きに突出している。そして、前記中継部28A~28Jの配列及びそのピッチに合わせてドレイン接続部22,26上に各FET14が一列に配され、これらFET14のドレイン端子が前記ドレイン接続部22,26に直接接触する状態で当該ドレイン接続部22,26上にFET14が溶接等(例えば半田付け)によって実装されるとともに、各FET14のソース端子14sが各中継部28A~28Jの後端に、ゲート端子14gが各制御用端子30の後端に、それぞれ半田付けなどの手段で電気的に接続されている。

#### [0050]

前記中継部28A~28Jの後部からは爪部が分岐しており、これらの爪部が 上向きに折り起こされることにより、タブ28tが形成されている。同様に、各

制御用端子30の前部にも爪部が形成され、これが上向きに折り起こされること により、タブ30tが形成されている。

[0051]

一方、前記金属板23の第2中継部25にはドレイン接続部22と平行に延びる矩形状の切欠25bが形成されており、この切欠25bの空間に複数の信号用端子32が配設されている。各信号用端子32は、小幅の短冊状をなし、前記ドレイン接続部22の長手方向と平行な方向に横一列に配列されるとともに、前記入力端子10I,10L及び出力端子12A~12Jと反対側の向き(図2では右向き)に突出している。これら信号用端子32の後部も爪部とされ、この爪部が上向きに折り起こされてタブ32tが形成されている。

[0052]

また、前記第2中継部25においても、前記信号用端子32と隣接する部分に 爪部が形成され、これが折り起こされてタブ25tが形成されている。そして、 このタブ25t及び前述のタブ28t,30t,32tがすべて共通の制御回路 基板18に接続されている。

[0053]

制御回路基板18は、図4に示すように、前記各端子が配列されている平面と略平行な状態(図では略水平な状態)で、前記FET14のすぐ上方の位置(FET14から離れた位置)に配設されている。そして、この制御回路基板18に設けられた貫通孔18hに前記各タブ28t,30t,32t,25tが挿通された状態で例えば半田付けされることにより、これらタブと制御回路基板18とが機械的に連結されるとともに、制御回路基板18に組み込まれた制御回路に各出力端子12A~12J、各制御用端子30、各信号用端子32、及び第2の入力端子10Lが電気的に接続されている。すなわち、この制御回路基板18は、制御用端子30と前記信号用端子32との間で前記FET14を跨ぐ位置に配されている。

[0054]

次に、前記各端子を一体化する樹脂モールドについて説明する。

[0055]

この樹脂モールドは、パワーディストリビュータのケース本体34を構成しており、後述のカバー60とともに、前記各FET14及び制御回路基板18を収納するケースを構成している。

[0056]

ケース本体34の適所には、これを厚み方向に貫通する複数の窓が形成されている。具体的には、各出力端子12A~12Jの分断部分を上下両側に露出させる矩形状のヒューズ用窓38や、各ドレイン接続部22,26をそれぞれ上下両側に露出させる素子用窓44等が形成されている。そして、前記ヒューズ用窓38内に各ヒューズ部FSが配列されるともに、素子用窓44内で各FET14のドレイン接続部22,26への実装が行われている(その他の窓については後述する。)。

[0057]

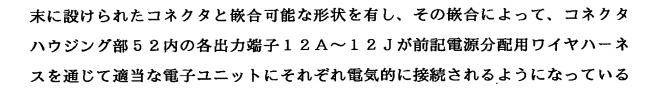
ケース本体34の一方の側面には、コネクタハウジング部50,52が一体に 形成されており、反対側の側面にはコネクタハウジング部54が形成されている。これらのコネクタハウジング部50,52,54は、外方に向かって開口する フード状をなしている。そして、前記コネクタハウジング部50内に前記両入力 端子10I,10Lが互いに横方向に隣接する状態で突出し、コネクタハウジン グ部52内に全出力端子12A~12Jが横一列に並ぶ状態で突出し、コネクタ ハウジング部54内に全信号用端子32が横一列に並ぶ状態で突出するように、 ケース本体34の成形が行われている。すなわち、ケース本体34の外側に突出 する各端子10I,10L,12A~12J,32は、ケース本体34と一体に 形成されたコネクタの雄端子を構成している。

[0058]

前記コネクタハウジング部50は、図略の電源入力用ワイヤハーネスの端末に 設けられたコネクタと嵌合可能な形状を有し、その嵌合によってコネクタハウジ ング部50内の各入力端子10I,10Lが前記電源入力用ワイヤハーネスを通 じて車載電源に電気的に接続されるようになっている。

[0059]

同様に、コネクタハウジング部52は、図略の電源分配用ワイヤハーネスの端



[0060]

また、コネクタハウジング部54は、図略の信号用ワイヤハーネスの端末に設けられたコネクタと嵌合可能な形状を有し、その嵌合によって、コネクタハウジング部54内の信号用端子32の一部が操作信号を発信する電子ユニット (例えばセンタークラスタユニット) に接続されるとともに、残りの信号用端子32の一部が警告表示動作を行う電子ユニット (例えばディスプレイ機能をもったセンタークラスタユニットあるいはメータユニットなど) に接続されるようになっている。

[0061]

前記ケース本体34の裏面(各端子が配置されている平面を挟んで前記制御回路基板18と反対側の面;図4では下面)には、その略全域(図例ではケース本体34の周縁部を除く領域)にわたって放熱部材56が配設されている。この放熱部材56は、例えばアルミニウム合金のように熱伝導性の高い(もしくは比熱の大きい)材料で全体が一体に形成されており、図例では全体が押し出し成形によって一体形成されたものが用いられている。

[0062]

この放熱部材56は、前記ケース本体34の裏面を覆うようにして、前記各端子が配置されている平面と略平行な状態で配設されている。この放熱部材56が外側に露出する面(図4(a)(b)では下面)には、前記FET14の配列方向と平行な方向(図4(a)(b)では奥行き方向)に延びる多数枚のフィン56fが形成される一方、ケース本体34の周縁部には、図7に示されるように前記各フィン56fと連続する形状のフィンカバー34fが形成され、これらのフィンカバー34fによって各フィン56fの両端部が側方から覆われている。

[0063]

前記放熱部材56の内側面(図4では上面)には、前記FET14の配列方向

と平行な方向に延びる台部56hが上向きに突設されている。これに対し、前記ケース本体34の下面には、前記素子用窓44を含んでFET配列方向に延びる窓43が形成され、この窓43内に前記台部56hが前記ケース本体34の素子用窓44内に下方から挿入されるとともに、この台部56fの表面に前記ドレイン接続部22,26の裏面がシリコーン等からなる絶縁シート58(図4(b))を介して熱的に接続されている。従って、この台部56hの高さ寸法hは、この台部56hと熱的に接続されるドレイン接続部22,26上に実装された各FET14のソース端子14s及びゲート端子14gがちょうど出力端子12A~12J及び制御用端子30と接続可能な高さに位置するような寸法に設定されている。

## [0064]

前記カバー60は、その周縁部が前記ケース本体34の表側面(図4では上面)に装着可能とされ、その装着状態で前記FET14及び制御回路基板18を外側から覆う形状を有している。さらに、このカバー60の内側面の適所には、前記ヒューズ部FSの両端に向かって延びる一対の縦仕切り壁62と、両縦仕切り壁62の間の空間をヒューズ部FSの個数と同数に仕切る横仕切り壁64とが形成されている。そして、図4に示すようにカバー60がケース本体34に装着された状態で、図5(a)に示すように前記縦仕切り壁62が各ヒューズ部FSをその両外側の空間から隔離し、同図(b)に示すように各横仕切り壁64が各ヒューズ部FS同士を隔離するように、両仕切り壁62,64の位置及び形状が設定されている。すなわち、両仕切り壁62,64によって、各ヒューズ部FSを個別に隔離する隔離部が構成されている。

#### [0065]

この隔離部の存在により、前記のようにヒューズ部材16を裸の状態で出力端子12A~12Jに組み込んでも、溶断したヒューズ部材16の破片が飛散して他の導体(例えば隣接するヒューズ部材16や出力端子)に接触して短絡を引き起こすことを確実に防止できる。しかも、前記隔離部はカバー60側に設けられているので、このカバー60を外した状態で出力端子12A~12Jに対して簡単にヒューズ部材16を実装することができる。

[0066]

具体的に、このパワーディストリビュータは、例えば次の工程を含む方法により、簡単な工程で容易に製造することが可能である。

[0067]

## 1) 打ち抜き工程

単一の金属板を例えばプレスにより所定形状に打ち抜くことにより、前記入力端子10I,10Lを含む金属板20,23と、出力端子12A~12J及びその中継部28A~28Jと、制御用端子30と、信号用端子32とがすべて一体につながった原板を製造する。

[0068]

具体的には、図10に示すような原板を製造する。この原板では、金属板20,23同士をつなぐ小幅のつなぎ部分27と、金属板20と出力端子12Aとの間及び出力端子同士をつなぐ小幅のつなぎ部分11と、各出力端子12A~12 Jの先端側の端子本体部分と中継部28A~28Jとの間をつなぐ小幅のつなぎ部分13と、金属板20と1本の制御用端子30との間及び制御用端子30とこれに隣接する中継部との間をつなぐ小幅のつなぎ部分29と、金属板23と1本の信号用端子32との間及び信号用端子32同士をつなぐ小幅のつなぎ部分31 と、金属板23と出力端子12Jの中継部28Jとをつなぐ小幅のつなぎ部分33とが形成され、これらのつなぎ部分によって全体が一体化されている。また、中継部28A~28J、制御用端子30、信号用端子32、及び金属板23の第2中継部25には、前記タブ28t,30t,32t,25tに相当する爪部が予め形成されている。

[0069]

#### 2)モールド工程

前記原板の外側にケース本体34を構成する樹脂モールドを成形する。この樹脂モールドには、図11に示すように、前記各つなぎ部分27,11,29,31,33をそれぞれ上下に露出させる切断用窓35,36,42,48,49と、ドレイン接続部22,26を上下に露出させる素子用窓44と、前記タブ28t,30tに相当する爪部を上下に露出させる端子用窓40と、前記タブ25t

,32tに相当する爪部を上下に露出させる端子用窓46と、前記つなぎ部分13を上下に露出させるヒューズ用窓38とを形成するとともに、ケース本体34の下面において前記素子用窓44,40とつながる位置に、放熱部材56の台部56hと略同一形状の窓43を形成しておく。

[0070]

## 3) 切断工程

前記切断用窓35,36,42,48,49を通じて前記つなぎ部分27,1 1,29,31,33を例えばプレスにより切断する。なお、この切断工程では 、後述のヒューズ配設工程に含まれる切断作業、すなわち、ヒューズ用窓38を 通じての各つなぎ部分13の切断も同時に行っておく方が効率的である。

[0071]

また、これらの窓35,36,42,48,49,38を図示のように表裏両側に開放させるようにしておけば、その両側からプレス用治具等を挿入することが可能になり、より簡単に各つなぎ部分の切断を行うことができる。

[0072]

#### 4)素子配設工程

前記素子用窓44内で各FET14の実装を行う。すなわち、各FET14の 裏面のドレイン端子をドレイン接続部22,26に接触させた状態で、半田付け 等の溶接によって当該ドレイン接続部22,26上にFET14を固定するとと もに、各FET14のソース端子14sを対応する中継部28A~28Jの後端 に、ゲート端子14gを対応する制御用端子30の後端に、それぞれ半田付け等 で接続する。

[0073]

#### 5)折り起こし工程

端子用窓40内で中継部28A~28J及び制御用端子30の爪部を折り起こすことによりタブ28t,30tを形成し、同様に端子用窓46内で金属板20及び信号用端子32の爪部を折り起こすことによりタブ25t,32tを形成する。

[0074]

### 6) 基板接続工程

FET14の直上方に制御回路基板18を配し、その制御回路基板18に設けられた貫通孔18hに各タブ28t,30t,25t,32tを挿通して半田付け等により固定する。これにより、各端子と制御回路基板18の制御回路とが電気的に接続される。

[0075]

## 7) ヒューズ部配設工程

前記ヒューズ用窓38を通じてつなぎ部分13を切断した後、この切断により 形成された端部同士の間にヒューズ部材16を介在させる。具体的には、図5( a)(b)に示すようにヒューズ部材16の両端部16bを前記切断により形成 された端部にそれぞれ溶接等により接合する。

[0076]

#### 8) 放熱部材の製造及び組み付け工程

前記パワーディストリビュータ本体の組み立てとは別に、放熱部材56の製造を行う。この実施の形態にかかる放熱部材56は、その台部56h及びフィン56hの長手方向が合致しているので、これら台部56h及びフィン56fを含む断面形状をもつ長尺物を例えば押し出し成形により形成し、これを適当な寸法に切断することによって量産が可能である。そして、この放熱部材56を前記ケース本体34の裏面に当該裏面を覆うようにして装着し、ボルトなどで固定する。その際、放熱部材56に突設された台部56hをケース本体34の窓43に挿入し、当該台部56hを絶縁シート58を介して金属板20,23のドレイン接続部(導体板)22,26に熱的に接続するようにする。

[0077]

#### 9)カバー装着工程

前記ケース本体34にカバー60を装着して各端子や制御回路基板18、ヒューズ部FSを覆う。その際、カバー裏面の仕切り壁62,64によって各ヒューズ部FSのヒューズ部材16が個別に隔離される。従って、ヒューズ部材16の溶断時にその破片等が他の導体部分に接触して短絡することを防止できる。

[0078]

なお、本発明の実施形態は以上のものに限られず、例として次のような形態を とることも可能である。

[0079]

・本発明において、使用する半導体スイッチング素子は前記パワーMOSFE Tに限らず、その他のトランジスタ(例えばIGBTや通常のバイポーラトランジスタ)やGTOをはじめとする各種サイリスタなど、スイッチング機能をもつ各種半導体素子を仕様に応じて適用することが可能である。また、かかる半導体スイッチング素子はパッケージ素子に限らず、例えば半導体チップを直接実装したものであってもよい。半導体スイッチング素子と各端子との接続形態も特に問わず、例えば適所にワイヤボンディングを用いるようにしてもよい。

[0080]

・ヒューズ部FSは各出力端子に一体に形成することも可能である。ただし、前記のように出力端子12A~12Jを途中で分割してその分割部分に別のヒューズ部材16を介在させるようにすれば、出力端子の材質には例えば安価なものを選択する一方で、ヒューズ部材16の材質にその溶断特性が得られやすいものを選択することが可能になる。好ましい材質としては、例えば銅や銅合金、アルミニウム合金などが挙げられる。

[0081]

・ヒューズ部材16同士を隔離する隔離部(図例では仕切り壁62,64)は、ケース本体34側に形成することも可能である。ただし、前記のようにカバー60の裏面側に隔離部を突設すれば、このカバー60を取り外した状態で、前記隔離部に邪魔されることなくヒューズ部材16の取付けを容易に行うことができる利点が得られる。

[0082]

・本発明において、樹脂モールドの具体的な形状は問わず、少なくともその樹脂モールドから各端子を外側に突出させることにより、外部回路との電気的接続が可能であり、また、ヒューズ用窓38の形成によってヒューズ部FSを支障なく配設することができる。また、樹脂モールド以外の手段で各端子を一体化するようにしてもよい。いずれの場合も、前記のように各端子を略同一平面上に配列

することにより、パワーディストリビュータ全体の大幅な薄型化が可能になる。

[0083]

・図2には、FET14が実装される導体板すなわちドレイン接続部22,26を、それぞれ入力端子10I,10Lと一体に形成する(単一の金属板20,23から形成する)ようにしたものを示したが、例えば金属板20,23とドレイン接続部22,26とを別部材とすることも可能である。また、入力端子から各出力端子ごとに素子接続部を分岐させ、この入力端子の各素子接続部に各半導体スイッチング素子の第1の通電端子(図例ではFET14のドレイン端子)を接続するようにしてもよい。

[0084]

### 【発明の効果】

以上のように本発明は、車載電源に接続される入力端子と各電子ユニットに接続される出力端子との間に半導体スイッチング素子が介在するパワーディストリビュータにおいて、いずれかの半導体スイッチング素子を流れる電流が予め設定された遮断電流を超える場合に当該半導体スイッチング素子を強制的にオフに切換える制御回路を備えるとともに、各半導体スイッチング素子と直列にヒューズ部が設けられ、前記半導体スイッチング素子が正常にオフ切換しないときには前記ヒューズ部の溶断によってその下流側の回路が過電流から保護されるようにしたものであるので、当該回路(例えばワイヤハーネスなどの回路要素)を過電流から確実に保護(二重保護)することができる。しかも、ヒューズ部の溶断頻度はきわめて低く、その交換作業は基本的に不要であるため、従来の電気接続箱に比べてメンテナンス作業は大幅に簡略化される。

#### 【図面の簡単な説明】

#### 【図1】

本発明の実施の形態にかかるパワーディストリビュータの回路図である。

### 【図2】

前記パワーディストリビュータの導体部分を示す平面図である。

#### 【図3】

前記パワーディストリビュータの全体平面図である。

【図4】

(a) は前記パワーディストリビュータの断面正面図、(b) はFET実装部 分の拡大断面図である。

【図5】

- (a) は前記パワーディストリビュータにおけるヒューズ部を示す断面正面図
- 、(b)は(a)のA-A線断面図である。

【図6】

前記パワーディストリビュータを上から見た分解斜視図である。

【図7】

前記パワーディストリビュータを下から見た斜視図である。

【図8】

(a)は前記パワーディストリビュータのカバーを示す断面正面図、(b)は 同カバーの底面図である。

【図9】

前記ヒューズ部の溶断特性の設計例を示すグラフである。

【図10】

前記パワーディストリビュータの製造方法における打ち抜き工程により打ち抜 かれた原板の形状を示す平面図である。

【図11】

前記原板の外側に樹脂モールドを成形したものを示す平面図である。

【図12】

前記樹脂モールドに形成された窓を通じて前記原板の各つなぎ部分を切断しか つタブを折り起こしたものを示す平面図である。

24

【符号の説明】

FS ヒューズ部

101,10L 入力端子

12A~12G 出力端子

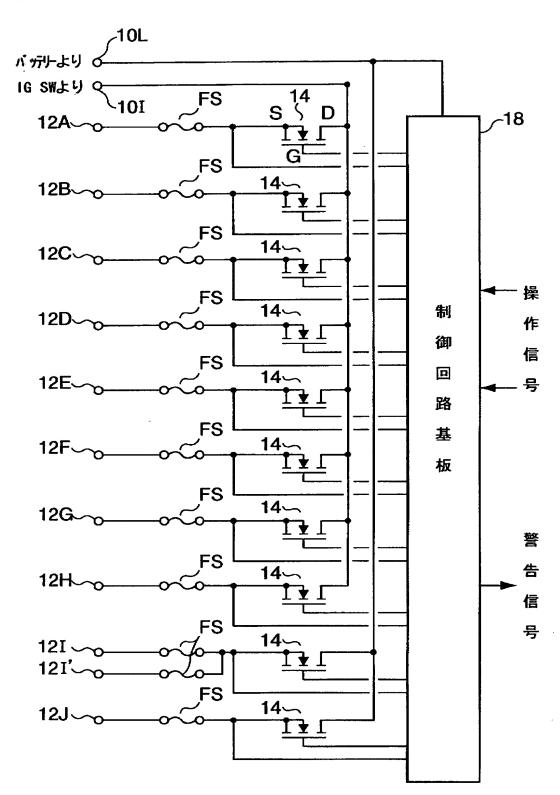
14 FET(半導体スイッチング素子)

14s ソース端子(第2の通電端子)

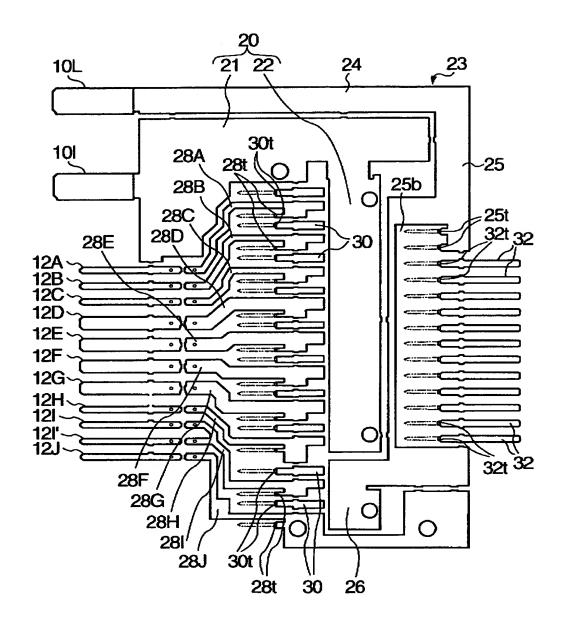
- 14g ゲート端子(通電制御端子)
- 16 ヒューズ部材
- 16b ヒューズ部材の両端部
- 18 制御回路基板
- 20,23 金属板
- 28A~28J 中継部 (素子接続部)
- 30 制御用端子
- 34 ケース本体
- 38 ヒューズ用窓
- 60 カバー
- 62,64 仕切り壁(隔離部)

【書類名】 図面

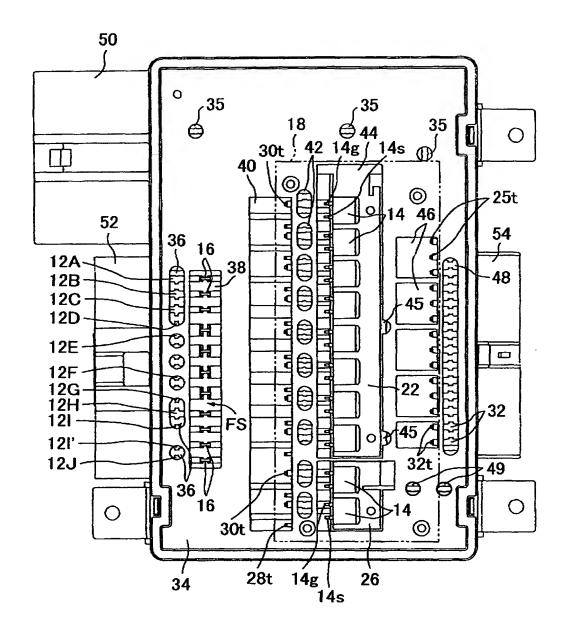
## 【図1】



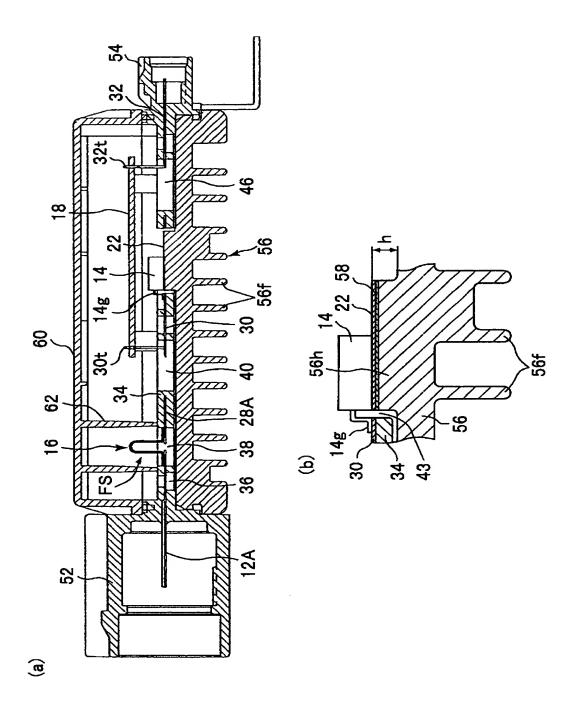
【図2】



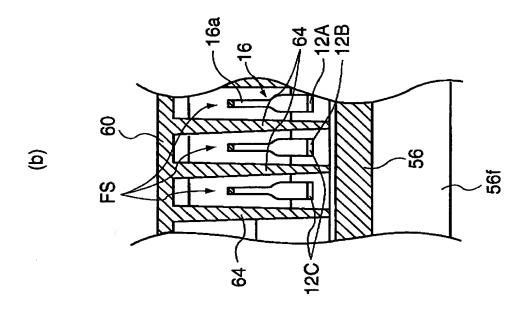
【図3】

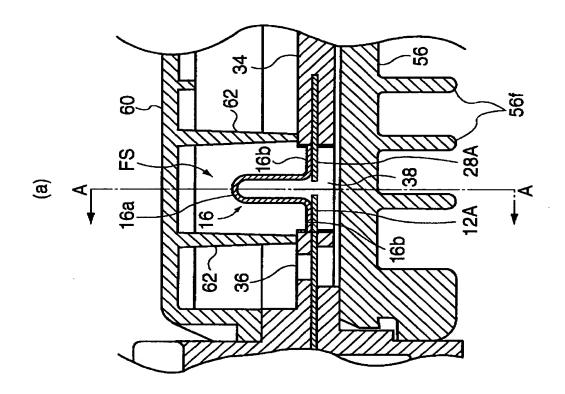


【図4】

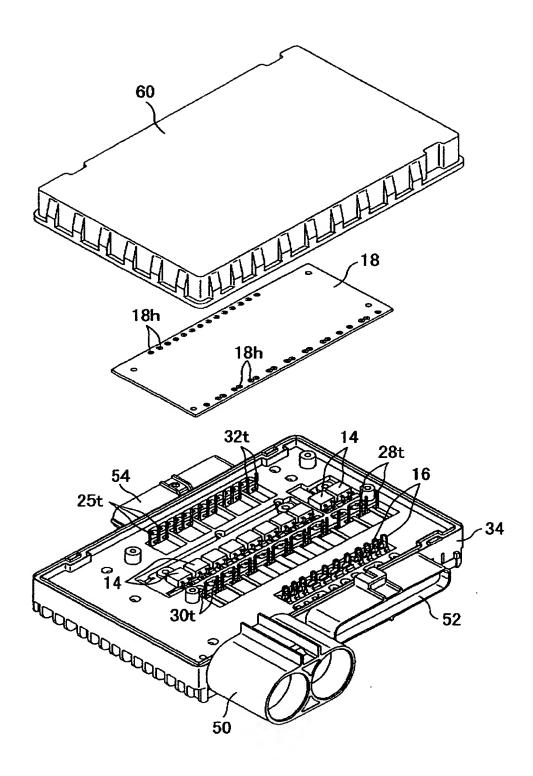


# 【図5】

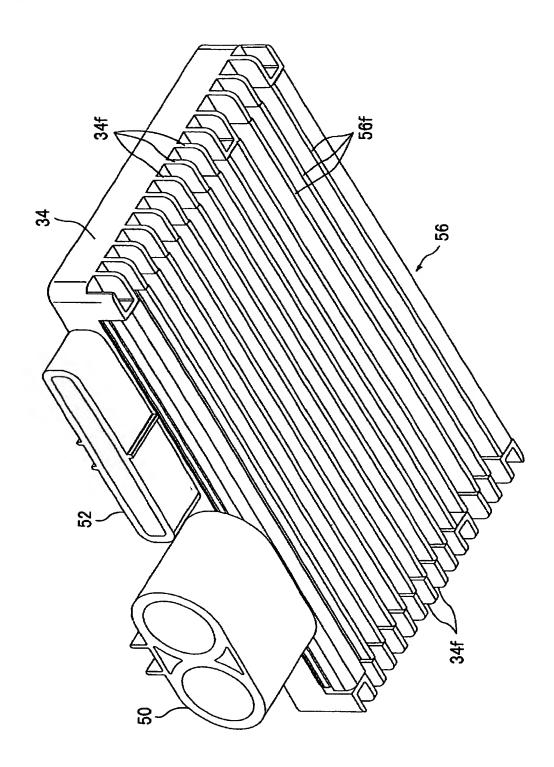




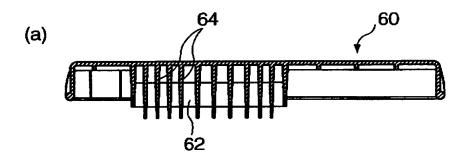
【図6】

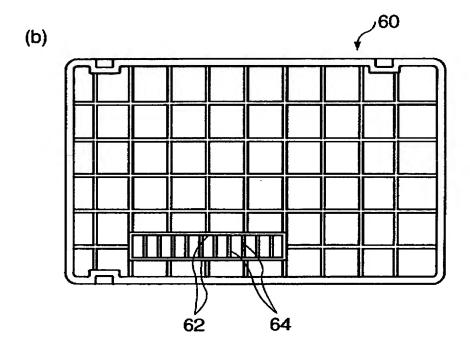


## 【図7】

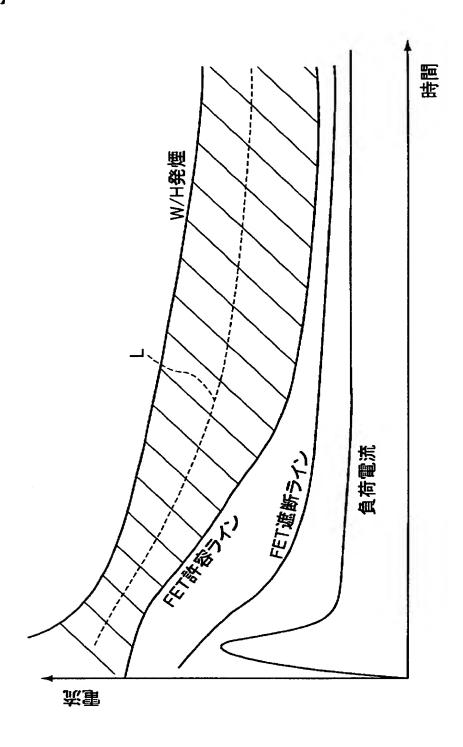


# 【図8】

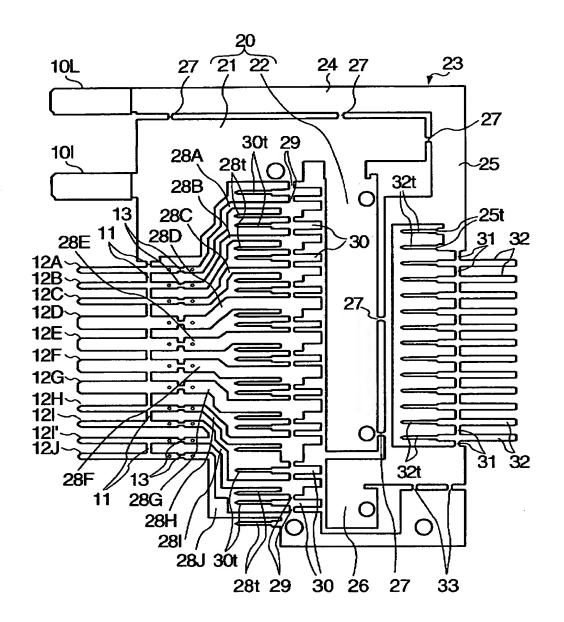




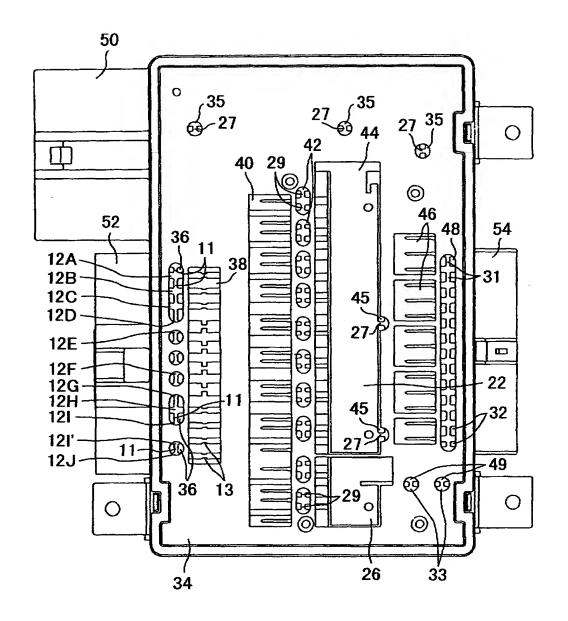
【図9】



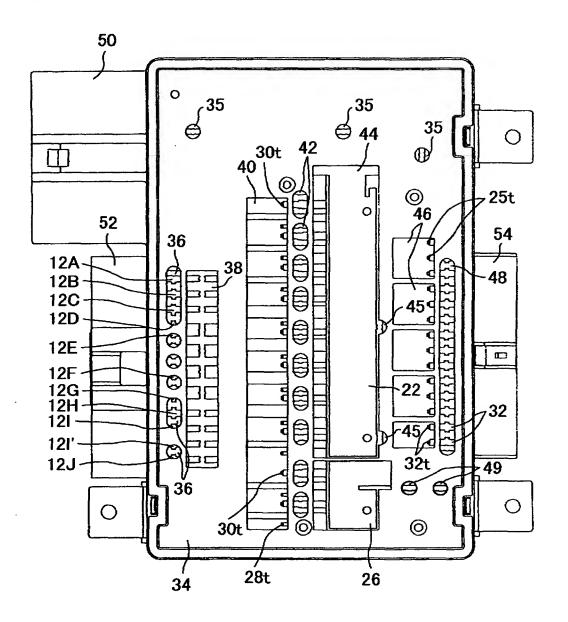
【図10】



【図11】



【図12】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 半導体スイッチング素子を利用したパワーディストリビュータにおいて、そのメンテナンス作業の簡略化を図りながら、下流側の回路を過電流から確実に保護する。

【解決手段】 車載電源に接続される入力端子10I,10Lと各電子ユニットに接続される複数の出力端子12A,…との間に各々FET14が介在し、いずれかのFET14を流れる電流が予め設定された遮断電流を超える場合に当該FET14を強制的にオフに切換える制御が行われる。さらに、各FET14と直列にヒューズ部FSが設けられ、FET14が正常にオフ切換しなくなったときには前記ヒューズ部FSの溶断によってその下流側回路を過電流から保護する。

【選択図】 図4

## 出願人履歴情報

識別番号 [395011665]

1. 変更年月日 1995年 6月 2日

[変更理由] 新規登録

住 所 愛知県名古屋市南区菊住1丁目7番10号

氏 名 株式会社ハーネス総合技術研究所

2. 変更年月日 2000年11月 1日

[変更理由] 名称変更

住 所 愛知県名古屋市南区菊住1丁目7番10号

氏 名 株式会社オートネットワーク技術研究所

## 出願人履歴情報

識別番号

[000183406]

1. 変更年月日

1990年 8月24日

[変更理由]

新規登録

住 所

三重県四日市市西末広町1番14号

氏 名 住友電装株式会社

## 出願人履歴情報

識別番号

[000002130]

1. 変更年月日

1990年 8月29日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号

氏 名

住友電気工業株式会社